

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re application of: **Mutsumi YANO, et al.**

Group Art Unit: **Not Yet Assigned**

Serial No.: **Not Yet Assigned**

Examiner: **Not Yet Assigned**

Filed: **July 3, 2003**

For: **ELECTROLYTIC CAPACITOR AND A FABRICATION METHOD THEREFOR**

CLAIM FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119

Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Date: July 3, 2003

Sir:

The benefit of the filing dates of the following prior foreign applications are hereby requested for the above-identified application, and the priority provided in 35 U.S.C. 119 is hereby claimed:

Japanese Appln. No. 2002-217482, filed July 26, 2002

Japanese Appln. No. 2003-080792, filed March 24, 2003

In support of this claim, the requisite certified copies of said original foreign applications are filed herewith.

It is requested that the file of this application be marked to indicate that the applicants have complied with the requirements of 35 U.S.C. 119 and that the Patent and Trademark Office kindly acknowledge receipt of said certified copies.

In the event that any fees are due in connection with this paper, please charge our Deposit Account No. 01-2340.

Respectfully submitted,

ARMSTRONG, WESTERMAN & HATTORI, LLP



Mel R. Quintos
Attorney for Applicants
Reg. No. 31,898

MRQ/jaz
Atty. Docket No. **030744**
Suite 1000
1725 K Street, N.W.
Washington, D.C. 20006
(202) 659-2930



23850

PATENT TRADEMARK OFFICE

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

出 願 年 月 日

Date of Application:

2002年 7月26日

出 願 番 号

Application Number:

特願2002-217482

[ST.10/C]:

[JP2002-217482]

出 願 人

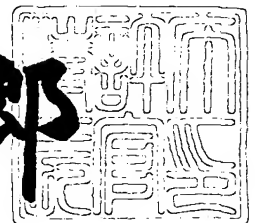
Applicant(s):

三洋電機株式会社

2003年 3月18日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

太田信一郎



出証番号 出証特2003-3017694

【書類名】 特許願

【整理番号】 NPA1021015

【提出日】 平成14年 7月26日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01G 9/00

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社
社内

 【氏名】 矢野 睦

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社
社内

 【氏名】 高谷 和宏

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府守口市京阪本通2丁目5番5号 三洋電機株式会社
社内

 【氏名】 木本 衛

【特許出願人】

 【識別番号】 000001889

 【氏名又は名称】 三洋電機株式会社

 【代表者】 桑野 幸徳

【代理人】

 【識別番号】 100087572

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 松川 克明

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 009656

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9401514

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 電解コンデンサ

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 ニオブ合金、チタン合金及びタングステン合金から選択される 1 種を用いた電極が陽極酸化されて、この電極の表面に誘電体層が形成されていることを特徴とする電解コンデンサ。

【請求項 2】 請求項 1 に記載の電解コンデンサにおいて、上記の電極に用いるニオブ合金が、ニオブに対してタングステン、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ハフニウム及びジルコニウムから選択される少なくとも 1 種の添加金属が添加されて合金化されたものであることを特徴とする電解コンデンサ。

【請求項 3】 請求項 1 に記載の電解コンデンサにおいて、上記の電極に用いるチタン合金が、チタンに対してタングステン、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ハフニウム及びジルコニウムから選択される少なくとも 1 種の添加金属が添加されて合金化されたものであることを特徴とする電解コンデンサ。

【請求項 4】 請求項 1 に記載の電解コンデンサにおいて、上記の電極に用いるタングステン合金が、タングステンに対してニオブ、チタン、タンタル、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ハフニウム及びジルコニウムから選択される少なくとも 1 種の添加金属が添加されて合金化されたものであることを特徴とする電解コンデンサ。

【請求項 5】 請求項 2～4 の何れか 1 項に記載した電解コンデンサにおいて、上記の合金中における添加金属の含有量が 0.01～5 wt % の範囲になっていることを特徴とする電解コンデンサ。

【請求項 6】 ニオブ又はニオブ合金からなる電極にフッ素がドーブされ、この電極が陽極酸化されて誘電体層が形成されていることを特徴とする電解コンデンサ。

【請求項 7】 ニオブ又はニオブ合金からなる電極をフッ素ガス雰囲気中で熱処理してフッ素をドーブさせた後、この電極を陽極酸化させて、この電極の表

面に誘電体層を形成することを特徴とする電解コンデンサの製造方法。

【請求項 8】 請求項 7 に記載した電解コンデンサの製造方法において、上記の熱処理する温度が 2 0 0 ℃ 以下であることを特徴とする電解コンデンサの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【 0 0 0 1 】

【発明の属する技術分野】

この発明は、電極が陽極酸化されて、この電極の表面に誘電体層が形成される電解コンデンサに係り、特に、陽極酸化時に誘電体層の結晶化が進んで、誘電体層の絶縁性が低下するのを抑制し、電解コンデンサにおける漏れ電流を少なくなるようにした点に特徴を有するものである。

【 0 0 0 2 】

【従来の技術】

近年、電子機器の小型化に伴って、小型で大容量のコンデンサの開発が要望されるようになった。

【 0 0 0 3 】

そして、このような大容量のコンデンサとして、近年においては、特開平 5 - 1 2 1 2 7 5 公報に示されるように、電極にチタンを用い、この電極を陽極酸化させて酸化チタンからなる誘電体層を形成した電解コンデンサや、特開平 1 1 - 3 1 2 6 2 8 公報に示されるように、整流作用を有する陽極酸化が可能なアルミニウム、タンタル、ニオブ、チタン等の弁作用金属の粉末の焼成体からなる電極を陽極酸化させて、この電極の表面にこれらの金属酸化物からなる誘電体層を形成した電解コンデンサが提案されている。

【 0 0 0 4 】

しかし、上記のように陽極酸化が可能なアルミニウム、タンタル、ニオブ、チタン等の弁作用金属を用いた電極を陽極酸化させて、この電極の表面にこれらの金属酸化物からなる誘電体層を形成するようにした場合、陽極酸化時にこれらの金属酸化物の結晶化が進み、これによって誘電体層の絶縁性が低下し、このような電解コンデンサにおける漏れ電流が増大するという問題があった。

【 0 0 0 5 】

【発明が解決しようとする課題】

この発明は、上記のように電極を陽極酸化させて、この電極の表面に誘電体層を形成するようにした電解コンデンサにおける上記のような問題を解決することを課題とするものであり、陽極酸化時において誘電体層の結晶化が進んで、誘電体層の絶縁性が低下するのを抑制し、漏れ電流の発生の少ない電解コンデンサが得られるようにすることを課題とするものである。

【 0 0 0 6 】

【課題を解決するための手段】

この発明における第 1 の電解コンデンサにおいては、上記のような課題を解決するため、電極にニオブ合金、チタン合金及びタングステン合金から選択される 1 種の合金を用い、この電極を陽極酸化させて、その表面に誘電体層を形成するようにしたのである。

【 0 0 0 7 】

そして、この第 1 の電解コンデンサのように、電極にニオブ合金、チタン合金及びタングステン合金から選択される 1 種の合金を用いると、ニオブやチタンやタングステン単体の金属を用いた場合に比べて、陽極酸化時に誘電体層が結晶化するのが抑制され、誘電体層の絶縁性が低下するのが防止されて、漏れ電流の発生の少ない電解コンデンサが得られるようになる。

【 0 0 0 8 】

ここで、上記のニオブ合金の種類については特に限定されないが、陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのを適切に抑制するためには、ニオブに対してタングステン、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ハフニウム及びジルコニウムから選択される少なくとも 1 種の添加金属が添加されて合金化されたニオブ合金を用いることが好ましい。

【 0 0 0 9 】

また、上記のチタン合金の種類についても特に限定されないが、陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのを適切に抑制するためには、チタンに対してタングステン、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ハフニウム及びジル

コニウムから選択される少なくとも 1 種の添加金属が添加されて合金化されたチタン合金を用いることが好ましい。

【 0 0 1 0 】

さらに、上記のタングステン合金の種類についても特に限定されないが、陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのを適切に抑制するためには、タングステンに対してニオブ、チタン、タンタル、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ハフニウム及びジルコニウムから選択される少なくとも 1 種の添加金属が添加されて合金化されたタングステン合金を用いることが好ましい。

【 0 0 1 1 】

また、上記のニオブ合金やチタン合金やタングステン合金において、上記のように添加させる添加金属の量が少ないと、陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのを適切に抑制することができなくなり、また添加金属の量が多くなり過ぎても、同様に陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのを適切に抑制することができなくなるため、上記の各合金中における添加金属の含有量が 0. 0 1 ~ 5 w t % の範囲になるようにすることが好ましい。

【 0 0 1 2 】

また、この発明における第 2 の電解コンデンサにおいては、上記のような課題を解決するため、ニオブ又はニオブ合金からなる電極にフッ素をドーブさせ、この電極を陽極酸化させて誘電体層を形成するようにしたのである。

【 0 0 1 3 】

そして、この第 2 の電解コンデンサのように、ニオブ又はニオブ合金からなる電極にフッ素をドーブさせ、この電極を陽極酸化させると、陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのが、ドーブされたフッ素によって抑制され、誘電体層の絶縁性が低下するのが防止されて、漏れ電流の発生の少ない電解コンデンサが得られるようになる。

【 0 0 1 4 】

ここで、この第 2 の電解コンデンサにおいて、電極を構成する材料にニオブ合金を用いると、前記のように陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのがさらに抑制されるようになる。また、このニオブ合金としては、前記のようにニオブ

に対して前記のような添加金属を添加させて合金化させたニオブ合金を用いることがより好ましく、さらにこのニオブ合金中における添加金属の含有量も上記のような範囲にすることが好ましい。

【 0 0 1 5 】

そして、上記の第 2 の電解コンデンサを製造するにあたっては、ニオブ又はニオブ合金からなる電極をフッ素ガス雰囲気中で熱処理してフッ素をドーブさせた後、この電極を陽極酸化させて、この電極の表面に誘電体層を形成させるようにする。

【 0 0 1 6 】

ここで、上記のようにニオブ又はニオブ合金からなる電極をフッ素ガス雰囲気中で熱処理してフッ素をドーブさせるにあたり、熱処理する温度がフッ化ニオブの沸点である 2 2 5 ℃ を越えると、フッ素を適切にドーブさせることができなくなるため、熱処理する温度を 2 0 0 ℃ 以下にすることが好ましく、より好ましくは、4 0 ℃ ～ 1 5 0 ℃ の温度で熱処理させるようにする。

【 0 0 1 7 】

【実施例】

以下、この発明の実施例に係る電解コンデンサについて具体的に説明すると共に、比較例を挙げ、この発明の実施例に係る電解コンデンサにおいては、誘電体層が結晶化するのが抑制されて、漏れ電流の発生の少なくなることを明らかにする。なお、この発明の電解コンデンサは下記の実施例に示したものに限定されるものではなく、その要旨を変更しない範囲において適宜変更して実施できるものである。

【 0 0 1 8 】

(実施例 A 1)

この実施例においては、ニオブ (Nb) 粉末 9 9 g に対して、添加金属としてタングステン (W) 粉末を 1 g 添加し、これらを回転揺動式混合装置により 2 0 分間混合させた。そして、この混合粉末を真空中において 1 5 0 0 ℃ で厚さ 1 0 0 μ m になるまで加圧し、ニオブ中にタングステンが拡散されて合金化されたニオブ合金箔を作製した。

【 0 0 1 9 】

そして、このニオブ合金箔を 1 c m × 5 c m の大きさに切断した後、このニオブ合金箔を、液温を 6 0 ℃ にした 0 . 6 体積 % の磷酸水溶液中において、 3 0 V の定電圧で陽極酸化させて、このニオブ合金箔からなる電極の表面に誘電体層を形成した。

【 0 0 2 0 】

そして、このように表面に誘電体層が形成されたニオブ合金箔からなる電極を陽極に用い、図 1 に示すように、ピーカ 1 に収容させた 2 w t % のホウ酸水溶液 2 中に上記の陽極 3 を浸漬させると共に、この陽極 3 の周囲を覆うようにして、活性炭で構成された円筒状の陰極 4 をこの陽極 3 と接触しないようにして、上記のホウ酸水溶液 2 中に浸漬させて、実施例 A 1 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 2 1 】

(実施例 A 2)

この実施例においては、ニオブ粉末に添加させる添加金属の種類を上記の実施例 A 1 の場合と変更し、ニオブ粉末 9 9 g に対して、バナジウム (V) 粉末を 1 g 加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 A 1 の場合と同様にして、実施例 A 2 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 2 2 】

(実施例 A 3)

この実施例においては、ニオブ粉末に添加させる添加金属の種類を上記の実施例 A 1 の場合と変更し、ニオブ粉末 9 9 g に対して、亜鉛 (Z n) 粉末を 1 g 加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 A 1 の場合と同様にして、実施例 A 3 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 2 3 】

(実施例 A 4)

この実施例においては、ニオブ粉末に添加させる添加金属の種類を上記の実施例 A 1 の場合と変更し、ニオブ粉末 9 9 g に対して、アルミニウム (A l) 粉末を 1 g 加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 A 1 の場合と同様にして、実

施例 A 4 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 2 4 】

(実施例 A 5)

この実施例においては、ニオブ粉末に添加させる添加金属の種類を上記の実施例 A 1 の場合と変更し、ニオブ粉末 9 9 g に対して、モリブデン (M o) 粉末を 1 g 加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 A 1 の場合と同様にして、実施例 A 5 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 2 5 】

(実施例 A 6)

この実施例においては、ニオブ粉末に添加させる添加金属の種類を上記の実施例 A 1 の場合と変更し、ニオブ粉末 9 9 g に対して、ジルコニウム (Z r) 粉末を 1 g 加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 A 1 の場合と同様にして、実施例 A 6 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 2 6 】

(実施例 A 7)

この実施例においては、ニオブ粉末に添加させる添加金属の種類を上記の実施例 A 1 の場合と変更し、ニオブ粉末 9 9 g に対して、ハフニウム (H f) 粉末を 1 g 加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 A 1 の場合と同様にして、実施例 A 7 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 2 7 】

(実施例 A 8)

この実施例においては、ニオブ粉末に添加させる添加金属の種類を上記の実施例 A 1 の場合と変更し、ニオブ粉末 9 9 g に対して、亜鉛粉末 0. 5 g とアルミニウム粉末 0. 5 g とを加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 A 1 の場合と同様にして、実施例 A 8 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 2 8 】

(比較例 a 1)

この比較例においては、上記の実施例 A 1 において、ニオブ粉末に対して添加金属のタングステン粉末を加えないようにして、ニオブだけで構成されたニオブ

箔を作製し、それ以外は、上記の実施例 A 1 の場合と同様にして、比較例 a 1 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 2 9 】

（実施例 B 1）

この実施例においては、チタン（Ti）粉末 99 g に対して、添加金属としてバナジウム（V）粉末を 1 g 加え、上記の実施例 A 1 の場合と同様に、これらを回転揺動式混合装置により 20 分間混合させた後、この混合粉末を真空中において 1500℃ で厚さ 100 μm になるまで加圧し、チタン中にバナジウムが拡散されて合金化されたチタン合金箔を作製した。

【 0 0 3 0 】

そして、このチタン合金箔を、上記の実施例 A 1 の場合と同様に、1 cm×5 cm の大きさに切断した後、このチタン合金箔を、液温を 60℃ にした 0.6 体積% の磷酸水溶液中において、30 V の定電圧で陽極酸化させて、このチタン合金箔からなる電極の表面に誘電体層を形成した。

【 0 0 3 1 】

そして、このように表面に誘電体層が形成されたチタン合金箔からなる電極を陽極に用い、それ以外は、上記の実施例 A 1 の場合と同様にして、実施例 B 1 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 3 2 】

（比較例 b 1）

この比較例においては、上記の実施例 B 1 において、チタン粉末に対して添加金属のバナジウム粉末を加えないようにして、チタンだけで構成されたチタン箔を作製し、それ以外は、上記の実施例 B 1 の場合と同様にして、比較例 b 1 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 3 3 】

次いで、上記のように作製した実施例 A 1 ～ A 8，B 1 及び比較例 a 1，b 1 の各試験用電解コンデンサを使用し、それぞれ 20 V に保持して、2 秒後の漏れ電流を測定した。そして、上記の実施例 A 1 の試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を 100 とした指数で、各試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を

求め、その結果を下記の表 1 に示した。

【 0 0 3 4 】

【表 1】

	電極の組成（重量比）	漏れ電流値
実施例 A 1	Nb : W = 99 : 1	100
実施例 A 2	Nb : V = 99 : 1	98
実施例 A 3	Nb : Zn = 99 : 1	101
実施例 A 4	Nb : Al = 99 : 1	96
実施例 A 5	Nb : Mo = 99 : 1	102
実施例 A 6	Nb : Zr = 99 : 1	103
実施例 A 7	Nb : Hf = 99 : 1	97
実施例 A 8	Nb : Zn : Al = 99 : 0.5 : 0.5	105
比較例 a 1	Nb = 100	250
実施例 B 1	Ti : V = 99 : 1	180
比較例 b 1	Ti = 100	500

【 0 0 3 5 】

この結果から明らかなように、ニオブに対してタングステン、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ジルコニウム及びハフニウムから選択される少なくとも 1 種の添加金属を添加させて合金化させたニオブ合金からなる電極を陽極酸化させたものを用いた実施例 A 1 ～ A 8 の各試験用電解コンデンサは、ニオブだけからなる電極を陽極酸化させたものを用いた比較例 a 1 の試験用電解コンデンサに比べて、漏れ電流が大きく減少していた。

【 0 0 3 6 】

また、チタンに対して、添加金属としてバナジウムを添加させて合金化させた

チタン合金からなる電極を陽極酸化させたものを用いた実施例 B 1 の試験用電解コンデンサも、チタンだけからなる電極を陽極酸化させたものを用いた比較例 b 1 の試験用電解コンデンサに比べて、漏れ電流が大きく減少していた。なお、チタンに対して、バナジウム以外のタングステン、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ジルコニウム及びハフニウムから選択される少なくとも 1 種の添加金属を添加させて合金化させたチタン合金からなる電極を陽極酸化させたものを用いた場合においても、同様の効果が得られる。

【 0 0 3 7 】

(実施例 A 1. 1 ~ A 1. 7)

これらの実施例 A 1. 1 ~ A 1. 7 においては、ニオブ (Nb) 粉末に対して添加金属として添加させるタングステン (W) 粉末の割合を、前記の実施例 A 1 の場合と変更させて、ニオブ合金中におけるタングステンの含有量 (wt %) を下記の表 2 に示すように変更させたニオブ合金箔を作製し、それ以外は、上記の実施例 A 1 の場合と同様にして、実施例 A 1. 1 ~ A 1. 7 の各試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 3 8 】

そして、このように作製した実施例 A 1. 1 ~ A 1. 7 の各試験用電解コンデンサについても、上記の場合と同様にして、漏れ電流を測定し、上記の実施例 A 1 の試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を 1 0 0 とした指数で、各試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を求め、その結果を下記の表 2 に示した。

【 0 0 3 9 】

【表 2】

	N b 合 金 中 の W 含 有 量 (w t %)	漏 れ 電 流 値
実 施 例 A 1 . 1	0 . 0 0 5	2 2 0
実 施 例 A 1 . 2	0 . 0 1	1 2 0
実 施 例 A 1 . 3	0 . 1	1 1 0
実 施 例 A 1 . 4	0 . 5	1 0 5
実 施 例 A 1	1 . 0	1 0 0
実 施 例 A 1 . 5	2 . 5	1 0 7
実 施 例 A 1 . 6	5 . 0	1 2 7
実 施 例 A 1 . 7	7 . 5	2 0 0

【 0 0 4 0 】

この結果から明らかなように、ニオブ合金中におけるタングステンの含有量が 0. 0 1 ~ 5 w t % の範囲になったものを用いた実施例 A 1 . 2 ~ A 1 . 6 及び A 1 の各試験用電解コンデンサにおいて漏れ電流値が低くなっており、特に、タングステンの含有量が 0. 1 ~ 2. 5 w t % の範囲になったものを用いた実施例 A 1 . 3 ~ A 1 . 5 及び A 1 の各試験用電解コンデンサにおいてはさらに漏れ電流値が低くなっていた。なお、ニオブに対して、タングステン以外のバナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン及びジルコニウムから選択される少なくとも 1 種の添加金属を添加させて合金化させたニオブ合金についても同様の結果が得られ、さらにチタン合金についても同様の結果が得られる。

【 0 0 4 1 】

(実施例 C 1)

この実施例においては、タングステン (W) 粉末 9 9 g に対して、添加金属としてニオブ (N b) 粉末を 1 g 加え、上記の実施例 A 1 の場合と同様に、これらを回転揺動式混合装置により 2 0 分間混合させた後、この混合粉末を真空中において 1 5 0 0 ℃ で厚さ 1 0 0 μ m になるまで加圧し、タングステン中にニオブが

拡散されて合金化されたタングステン合金箔を作製した。

【 0 0 4 2 】

そして、このタングステン合金箔を、上記の実施例 A 1 の場合と同様に、1 c m × 5 c m の大きさに切断した後、このタングステン合金箔を、液温を 6 0 ° C にした 0 . 6 体積 % の磷酸水溶液中において、3 0 V の定電圧で陽極酸化させて、このタングステン合金箔からなる電極の表面に誘電体層を形成した。

【 0 0 4 3 】

そして、このように表面に誘電体層が形成されたタングステン合金箔からなる電極を陽極に用い、それ以外は、上記の実施例 A 1 の場合と同様にして、実施例 C 1 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 4 4 】

(実施例 C 2)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例 C 1 の場合と変更し、タングステン粉末 9 9 g に対して、チタン (T i) 粉末を 1 g 加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 C 1 の場合と同様にして、実施例 C 2 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 4 5 】

(実施例 C 3)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例 C 1 の場合と変更し、タングステン粉末 9 9 g に対して、タンタル (T a) 粉末を 1 g 加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 C 1 の場合と同様にして、実施例 C 3 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 4 6 】

(実施例 C 4)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例 C 1 の場合と変更し、タングステン粉末 9 9 g に対して、バナジウム (V) 粉末を 1 g 加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 C 1 の場合と同様にして、実施例 C 4 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 4 7 】

(実施例 C 5)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例 C 1 の場合と変更し、タングステン粉末 9 9 g に対して、亜鉛 (Zn) 粉末を 1 g 加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 C 1 の場合と同様にして、実施例 C 5 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 4 8 】

(実施例 C 6)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例 C 1 の場合と変更し、タングステン粉末 9 9 g に対して、アルミニウム (Al) 粉末を 1 g 加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 C 1 の場合と同様にして、実施例 C 6 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 4 9 】

(実施例 C 7)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例 C 1 の場合と変更し、タングステン粉末 9 9 g に対して、モリブデン (Mo) 粉末を 1 g 加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 C 1 の場合と同様にして、実施例 C 7 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 5 0 】

(実施例 C 8)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例 C 1 の場合と変更し、タングステン粉末 9 9 g に対して、ジルコニウム (Zr) 粉末を 1 g 加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 C 1 の場合と同様にして、実施例 C 8 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 5 1 】

(実施例 C 9)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例 C 1 の場合と変更し、タングステン粉末 9 9 g に対して、ハフニウム (Hf) 粉末を 1 g 加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 C 1 の場合と同様にして、実施例 C 9 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 5 2 】

(実施例 C 1 0)

この実施例においては、タングステン粉末に対して添加させる添加金属の種類を上記の実施例 C 1 の場合と変更し、タングステン粉末 9 9 g に対して、タンタル粉末 0. 5 g とニオブ粉末 0. 5 g とを加えるようにし、それ以外は、上記の実施例 C 1 の場合と同様にして、実施例 C 1 0 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 5 3 】

(比較例 c 1)

この比較例においては、上記の実施例 C 1 において、タングステン粉末に対して添加金属のニオブ粉末を加えないようにして、タングステンだけで構成されたタングステン箔を作製し、それ以外は、上記の実施例 C 1 の場合と同様にして、比較例 c 1 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 5 4 】

そして、このように作製した実施例 C 1 ～ C 1 0 及び比較例 c 1 の各試験用電解コンデンサと、参考のために前記の比較例 a 1 及び比較例 b 1 の各試験用電解コンデンサを使用し、それぞれ 2 0 V に保持して、2 秒後の漏れ電流を測定した。そして、上記の実施例 C 1 の試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を 1 0 0 とした指数で、上記の各試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を求め、その結果を下記の表 3 に示した。

【 0 0 5 5 】

【表 3】

	電極の組成（重量比）	漏れ電流値
実施例 C 1	W : N b = 9 9 : 1	1 0 0
実施例 C 2	W : T i = 9 9 : 1	1 1 0
実施例 C 3	W : T a = 9 9 : 1	9 6
実施例 C 4	W : V = 9 9 : 1	9 8
実施例 C 5	W : Z n = 9 9 : 1	1 0 6
実施例 C 6	W : A l = 9 9 : 1	9 7
実施例 C 7	W : M o = 9 9 : 1	1 1 2
実施例 C 8	W : Z r = 9 9 : 1	1 0 2
実施例 C 9	W : H f = 9 9 : 1	9 7
実施例 C 10	W : T a : N b = 9 9 : 0 . 5 : 0 . 5	9 4
比較例 c 1	W = 1 0 0	6 0 0
比較例 a 1	N b = 1 0 0	2 4 0
比較例 b 1	T i = 1 0 0	4 5 0

【 0 0 5 6 】

この結果から明らかなように、タングステンに対して、ニオブ、チタン、タンタル、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ジルコニウム及びハフニウムから選択される少なくとも 1 種の添加金属を添加させて合金化させたタングステン合金からなる電極を陽極酸化させたものを用いた実施例 C 1 ～ C 1 0 の各試験用電解コンデンサは、タングステンだけからなる電極を陽極酸化させたものを用いた比較例 c 1 の試験用電解コンデンサや、ニオブだけからなる電極を陽極酸化させたものを用いた比較例 a 1 の試験用電解コンデンサや、チタンだけからなる電極を陽極酸化させたものを用いた比較例 b 1 の試験用電解コンデンサに比べて、漏れ電流が大きく減少していた。

【 0 0 5 7 】

(実施例 C 1. 1 ~ C 1. 7)

これらの実施例 C 1. 1 ~ C 1. 7 においては、タングステン (W) 粉末に対して、添加金属として添加させるニオブ (Nb) 粉末の割合を、前記の実施例 C 1 の場合と変更させて、タングステン合金中におけるニオブの含有量 (wt %) を下記の表 4 に示すように変更させたタングステン合金箔を作製し、それ以外は、上記の実施例 C 1 の場合と同様にして、実施例 C 1. 1 ~ C 1. 7 の各試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 5 8 】

そして、このように作製した実施例 C 1. 1 ~ C 1. 7 の各試験用電解コンデンサについても、上記の場合と同様にして、漏れ電流を測定し、上記の実施例 C 1 の試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を 1 0 0 とした指数で、各試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を求め、その結果を下記の表 4 に示した。

【 0 0 5 9 】

【表 4】

	W 合金中の Nb 含有量 (wt %)	漏れ電流値
実施例 C 1. 1	0. 0 0 5	2 2 0
実施例 C 1. 2	0. 0 1	1 1 5
実施例 C 1. 3	0. 1	1 0 8
実施例 C 1. 4	0. 5	1 0 5
実施例 C 1	1. 0	1 0 0
実施例 C 1. 5	2. 5	1 1 0
実施例 C 1. 6	5. 0	1 1 7
実施例 C 1. 7	7. 5	2 1 0

【 0 0 6 0 】

この結果から明らかなように、タングステン合金中におけるニオブの含有量が

0.01～5 wt %の範囲になったものを用いた実施例C1.2～C1.6及びC1の各試験用電解コンデンサにおいて漏れ電流値が低くなっており、特に、タングステンの含有量が0.1～2.5 wt %の範囲になったものを用いた実施例C1.3～C1.5及びC1の各試験用電解コンデンサにおいてはさらに漏れ電流値が低くなっていた。なお、タングステンに対して、ニオブ以外のチタン、タンタル、バナジウム、亜鉛、アルミニウム、モリブデン、ジルコニウム及びハフニウムから選択される少なくとも1種の添加金属を添加させて合金化させたタングステン合金についても同様の結果が得られる。

【0061】

(実施例D1)

この実施例においては、前記の比較例a1の場合と同様にして、ニオブだけで構成された、厚さが100 μ m、大きさが1 cm×5 cmになったニオブ箔からなる電極を作製した後、この電極をフッ素ガス雰囲気中において60℃で1時間熱処理して、この電極中にフッ素をドーブさせた。

【0062】

そして、このようにフッ素がドーブされた電極を、液温を60℃にした0.6体積%の磷酸水溶液中において30Vの定電圧で陽極酸化させて、このニオブ箔からなる電極の表面に誘電体層を形成した。ここで、このように形成した誘電体層をXPS(X線電子分光分析)によって分析したところ、この誘電体層中にフッ素がドーブされていた。

【0063】

次いで、このようにフッ素がドーブされた誘電体層が形成されたニオブ箔からなる電極を陽極に用い、それ以外は、上記の実施例A1の場合と同様にして、実施例D1の試験用電解コンデンサを作製した。

【0064】

(実施例D2)

この実施例においては、前記の実施例A1の場合と同様にして、ニオブ合金中にタングステンが1 wt %含有され、厚さが100 μ m、大きさが1 cm×5 cmになったニオブ合金箔からなる電極を作製した後、この電極をフッ素ガス雰囲気

気中において 6 0℃で 1 時間熱処理して、この電極中にフッ素をドーブさせた。

【 0 0 6 5 】

そして、このようにフッ素がドーブされた電極を、液温を 6 0℃にした 0. 6 体積%の磷酸水溶液中において 3 0 V の定電圧で陽極酸化させて、このニオブ合金箔からなる電極の表面に誘電体層を形成した。ここで、このように形成した誘電体層を X P S (X 線電子分光分析) によって分析したところ、上記の実施例 D 1 の場合と同様に、この誘電体層中にフッ素がドーブされていた。

【 0 0 6 6 】

次いで、このようにフッ素がドーブされた誘電体層が形成されたニオブ合金箔からなる電極を陽極に用い、それ以外は、上記の実施例 A 1 の場合と同様にして、実施例 D 2 の試験用電解コンデンサを作製した。

【 0 0 6 7 】

そして、上記のように電極にフッ素をドーブさせて陽極酸化させた電極を用いた実施例 D 1, D 2 の各試験用電解コンデンサと、参考のために電極にフッ素をドーブさせずに陽極酸化させた電極を用い前記の比較例 a 1, 実施例 A 1 の各試験用電解コンデンサを使用し、それぞれ 2 0 V に保持して、2 秒後の漏れ電流を測定した。そして、上記の実施例 D 1 の試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を 1 0 0 とした指数で、上記の各試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を求め、その結果を下記の表 5 に示した。

【 0 0 6 8 】

【表 5】

	電極の組成（重量比）	フッ素のドーピング	漏れ電流値
実施例 D 1	Nb = 100	有	125
比較例 a 1	Nb = 100	無	270
実施例 D 2	Nb : W = 99 : 1	有	100
実施例 A 1	Nb : W = 99 : 1	無	108

【0069】

この結果から明らかなように、電極中にフッ素をドーピングさせ、このようにフッ素がドーピングされた電極を陽極酸化させて、表面にフッ素がドーピングされた誘電体層を形成した電極を使用した実施例 D 1、D 2 の各試験用電解コンデンサは、電極中にフッ素をドーピングさせなかった対応する比較例 a 1、実施例 A 1 の各試験用電解コンデンサに比べて、漏れ電流が小さくなっていた。

【0070】

（実施例 D 1. 1～D 1. 6）

これらの実施例 D 1. 1～D 1. 6 においては、上記の実施例 D 1 において、ニオブ箔からなる電極をフッ素ガス雰囲気中で熱処理する温度だけを下記の表 6 に示すように変更し、それ以外は、上記の実施例 D 1 の場合と同様にして、実施例 D 1. 1～D 1. 6 の各試験用電解コンデンサを作製した。

【0071】

そして、このように作製した実施例 D 1. 1～D 1. 6 の各試験用電解コンデンサについても、上記の場合と同様にして、漏れ電流を測定し、上記の実施例 D 1 の試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を 100 とした指数で、各試験用電解コンデンサにおける漏れ電流値を求め、その結果を下記の表 6 に示した。

【0072】

【表 6】

	熱処理温度 (℃)	漏れ電流値
実施例 D 1. 1	3 0	1 1 5
実施例 D 1. 2	4 0	1 0 2
実施例 D 1	6 0	1 0 0
実施例 D 1. 3	1 0 0	1 0 2
実施例 D 1. 4	1 5 0	1 0 5
実施例 D 1. 5	2 0 0	1 1 0
実施例 D 1. 6	2 2 5	2 1 5

【0 0 7 3】

この結果から明らかなように、電極をフッ素ガス雰囲気中で熱処理して、電極中にフッ素をドーピングさせるにあたり、その熱処理温度をフッ化ニオブの沸点である 2 2 5℃より低い 3 0～2 0 0℃の範囲にした実施例 D 1, D 1. 1～D 1. 5 の各試験用電解コンデンサは、熱処理温度をフッ化ニオブの沸点である 2 2 5℃にした実施例 D 1. 6 の試験用電解コンデンサに比べて、漏れ電流が小さくなっており、特に熱処理温度を 4 0～1 5 0℃の範囲にした実施例 D 1, D 1. 2～D 1. 4 の試験用電解コンデンサにおいては、さらに漏れ電流が少なくなっていた。

【0 0 7 4】

【発明の効果】

以上詳述したように、この発明における第 1 の電解コンデンサにおいては、電極にニオブ合金、チタン合金及びタングステン合金から選択される 1 種の合金を用い、この電極を陽極酸化させて、その表面に誘電体層を形成するようにしたため、ニオブやチタンやタングステン単体の金属を電極に用いる場合に比べて、陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのが抑制され、誘電体層の絶縁性が低下するのが防止されて、漏れ電流の発生の少ない電解コンデンサが得られるように

なった。

【 0 0 7 5 】

また、この発明における第 2 の電解コンデンサにおいては、ニオブ又はニオブ合金からなる電極にフッ素をドーピングさせ、この電極を陽極酸化させて誘電体層を形成するようにしたため、この陽極酸化時において誘電体層が結晶化するのが抑制され、誘電体層の絶縁性が低下するのが防止されて、漏れ電流の発生が少ない電解コンデンサが得られるようになった。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

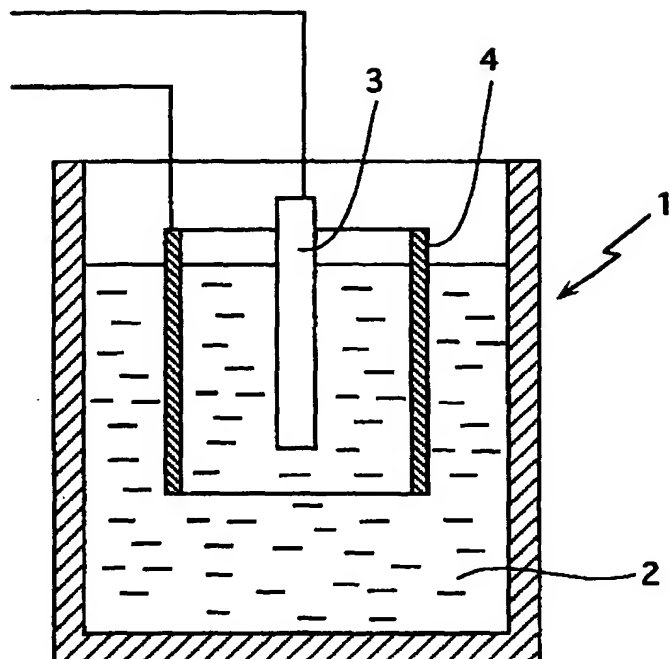
この発明の各実施例及び各比較例において作製した試験用電解コンデンサの概略説明図である。

【符号の説明】

- 3 陽極
- 4 陰極

【書類名】 図面

【図 1】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 電極を陽極酸化させて、表面に誘電体層を形成するようにした電解コンデンサにおいて、陽極酸化時に誘電体層の絶縁性が低下するのを抑制して、漏れ電流の発生の少ない電解コンデンサが得られるようにする。

【解決手段】 第 1 の電解コンデンサにおいては、電極 3 にニオブ合金、チタン合金及びタングステン合金から選択される 1 種の合金を用い、この電極 3 を陽極酸化させてその表面に誘電体層を形成し、また第 2 の電解コンデンサにおいては、ニオブ又はニオブ合金を用いた電極 3 にフッ素をドーピングさせ、この電極 3 を陽極酸化させて誘電体層を形成した。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 0 0 1 8 8 9]

1. 変更年月日	1 9 9 3 年 1 0 月 2 0 日
[変更理由]	住所変更
住 所	大阪府守口市京阪本通 2 丁目 5 番 5 号
氏 名	三洋電機株式会社